

$R1^* = (300 - 600) \text{ Ом} - \text{регулируемое}$

$R_N = 10 \text{ кОм} \pm 10\%$

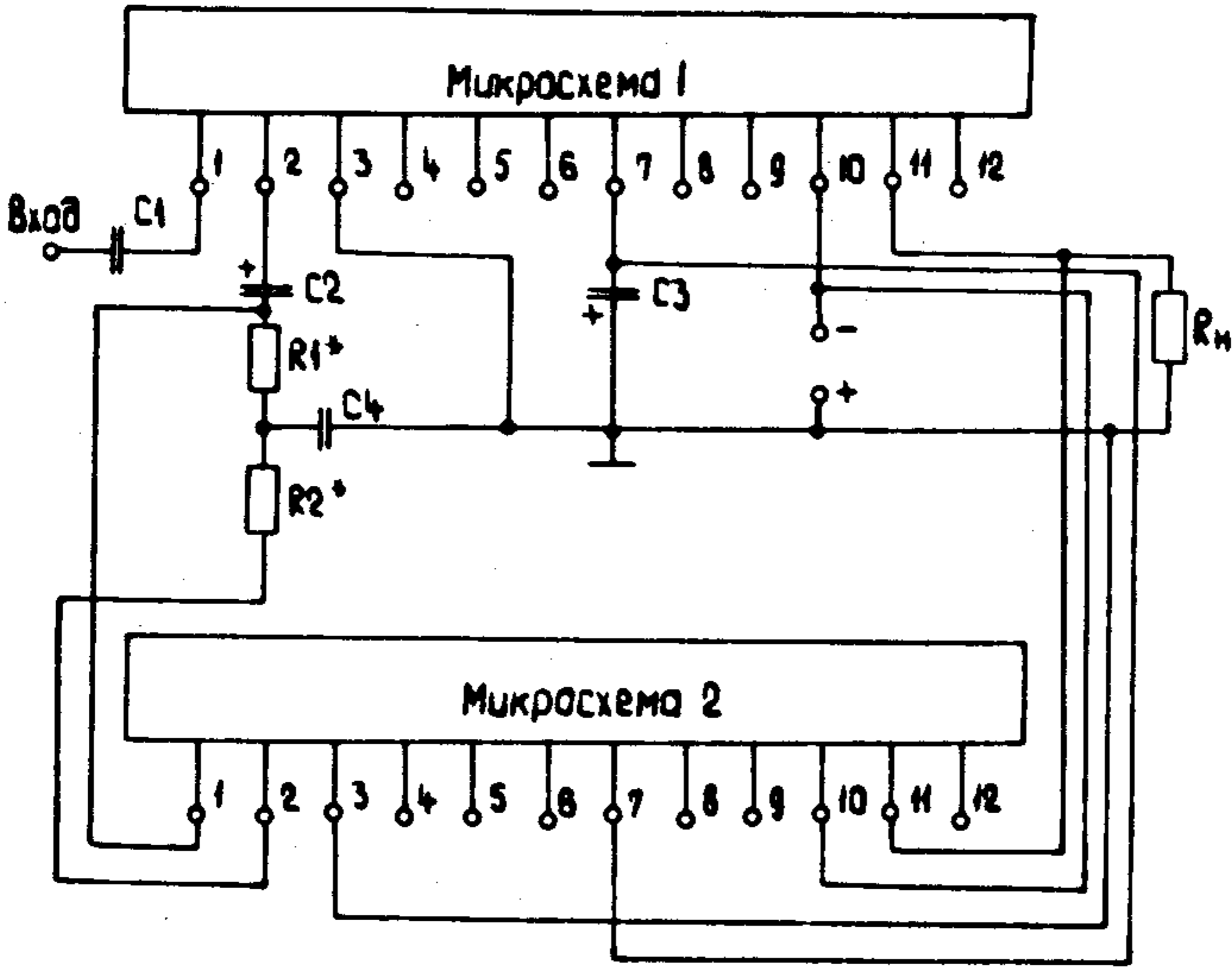
$C1 = 1 \text{ мкФ} \pm 10\%$

$C2 = 10 \text{ мкФ} \pm 10\%$

$C3 = 10 \text{ мкФ} \pm 10\%$

Схема включения микросхемы при использовании в качестве однополупериодного детектора.

* Настоящая регулировка предусматривает изменение коэффициента передачи микросхемы K на минус 6 дБ
Примечание. Ток утечки конденсаторов $C1, C2$ не должен превышать 0,1 мкА



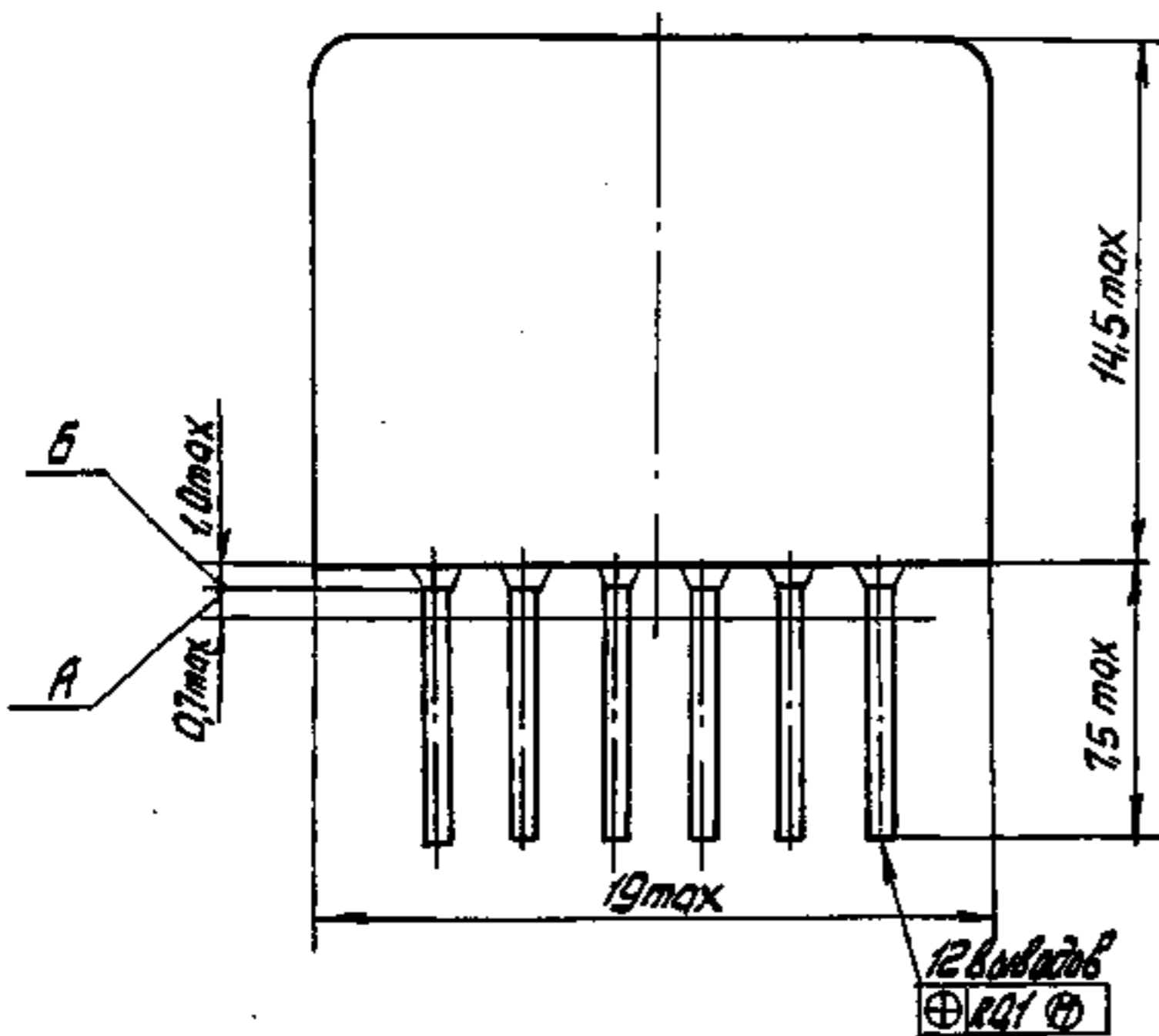
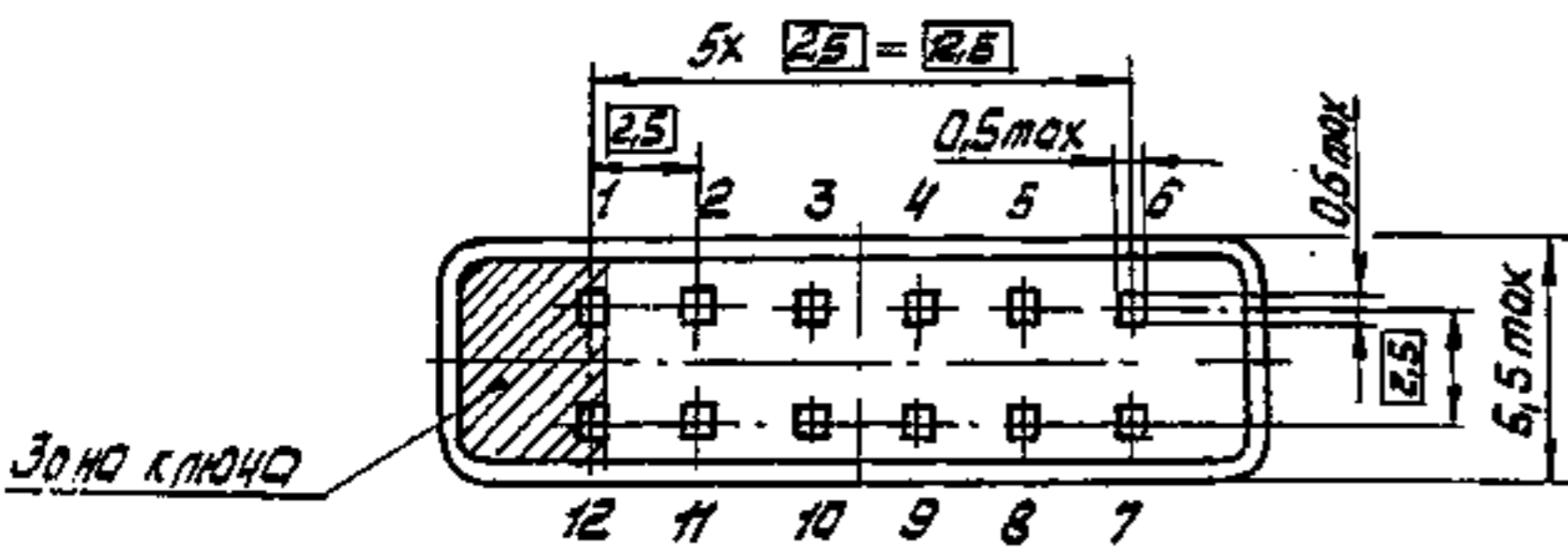
$R1^* = R2^* = (300-600) \text{ Ом} - \text{регулируемое}$
 $R_n = 5,1 \text{ кОм} \pm 5\%$
 $C1 = 1 \text{ мкФ} \pm 10\%$
 $C2 = C3 = 10 \text{ мкФ} \pm 10\%$
 $C4 = 1500 \text{ пФ} \pm 10\%$

Настоящая регулировка предусматривает изменение коэффициента передачи микросхемы K на минус 6 дБ.

Примечание. Ток утечки конденсатора $C1$ не более 0,1 пкА

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ В КОРПУСЕ III.12-1

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



1. А-длина вывода, в пределах которой установлено смещение осей выводов от номинального расположения.

2. Б-длина выводов, непригодная для монтажа.

3. Нумерация выводов показана условно.